



EMLT0050M44P7

DC-50MHz 限幅器封装芯片

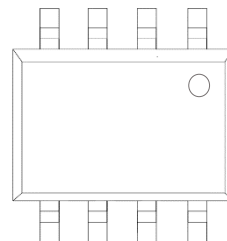
Jan 16 2024



Product datasheet

概要描述

EMLT0050M44P7 是一款性能优良的 GaAs 限幅器封装芯片。该芯片采用 ESOP8 封装，具有低插入损耗、高耐功率的特点。



关键技术指标及应用

射频应用中的关键指标参数

- 频率范围：0-50MHz
- 输入/输出驻波：1.2/1.2
- 插入损耗：0.2dB
- 耐功率：30W
- 应用于 TR 收发模块、射频微波系统等

允许绝对最大值

应用极限值

符号	参数	数值	备注
Pin	输入功率	45dBm	
Tch	工作温度	150°C	
Tstg	存储温度	-65~+150°C	

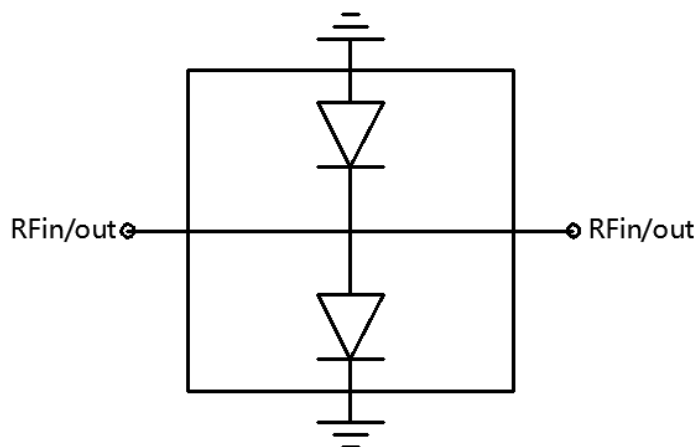
超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

射频指标参数

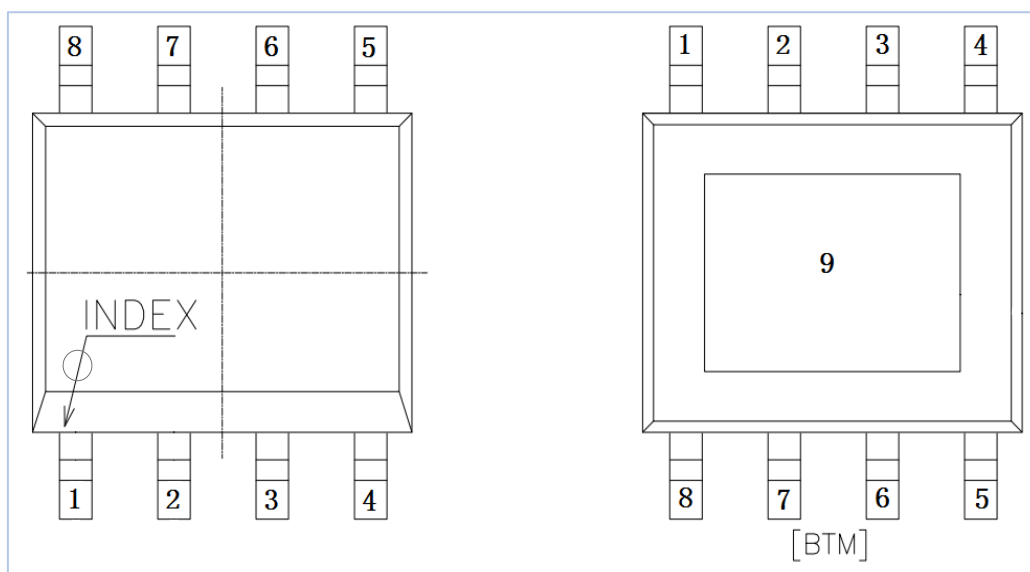
测试条件：频率：2000 – 4000MHz， TA=25°C

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VSWR_in	输入驻波	-	1.2	-	-
VSWR_out	输出驻波	-	1.2	-	-
P _{lim}	限幅输出电平	-	15	-	dBm
IL	插入损耗		0.2		dB

功能框图

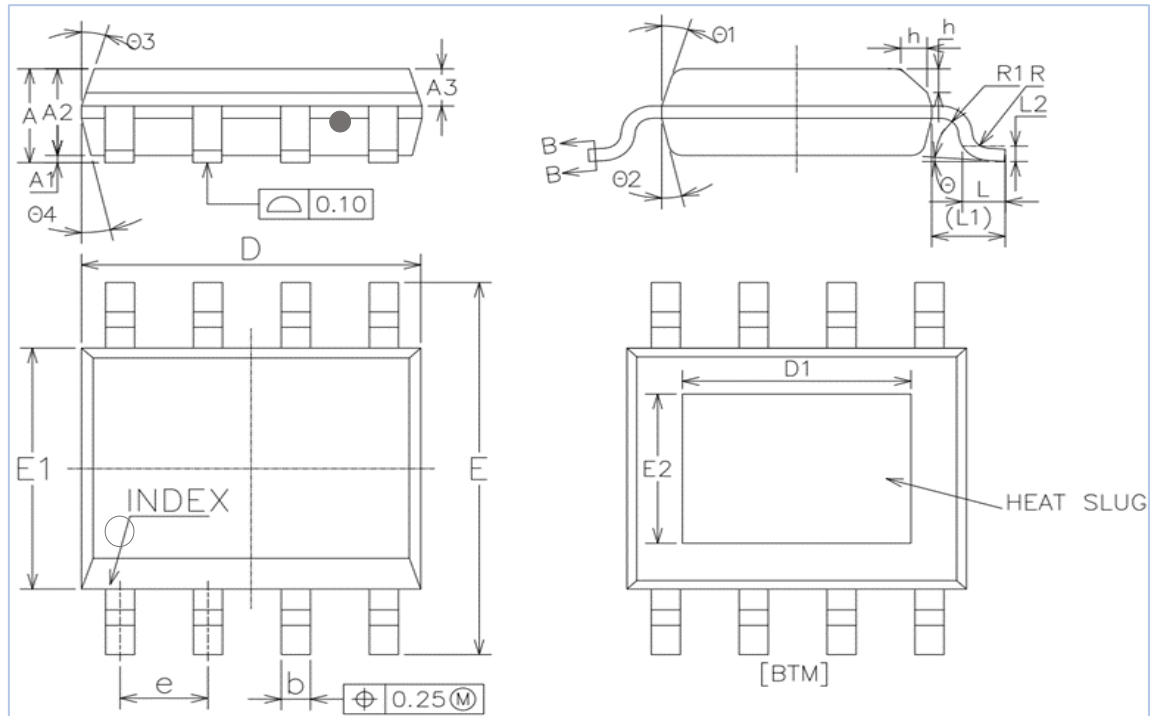


芯片引脚描述



引脚序号	定义	描述
2	RFin	RF 输入
7	RFout	RF 输出
1、3、6、8、9	GND	建议接 GND，也可悬空

芯片尺寸图



符号	最小值	典型值	最大值	符号	最小值	典型值	最大值
A	1.35	1.55	1.70	e	1.17	1.27	1.37
A1	0	0.10	0.15	L	0.45	0.60	0.80
A2	1.25	1.40	1.65	L1	1.04REF		
A3	0.50	0.60	0.70	L2	0.25BSC		
b	0.38	-	0.51	R	0.07	--	--
b1	0.37	0.42	0.47	R1	0.07	--	--
C	0.17	--	0.25	h	0.30	0.40	0.50
c1	0.17	0.20	0.23	θ	0	--	8°
D	4.80	4.90	5.00	θ1	15°	17°	19°
D1	3.10	3.30	3.50	θ2	11°	13°	15°
E	5.80	6.00	6.20	θ3	15°	17°	19°
E1	3.80	3.90	4.00	θ4	11°	13°	15°
E2	2.20	2.40	2.60				

封装信息

产品名称	正面封装标记	批次号	包装
EMLT0050M44P7	EMLT005	yyww	ESOP8

注意：“yy”即 year 表示年份，“ww”即 weak 表示周数。

版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2023-06-25	1.0	发布初版数据手册	
2024-01-16	1.1	增加封装信息说明	

注意事项

- (1) 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>。
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。